

1. Title of the Invention

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

2. Scope of Claims

(1) A liquid crystal display device, in which a plurality of liquid crystal driving elements are arranged in a matrix on a substrate of a display panel, the perimeter of a glass electrode plate with a transparent electrode attached thereto is stuck to the opposite surface of the substrate to form a given gap between the substrate and the glass electrode plate and place liquid crystal material in the gap, characterize in that: a post having a height corresponding to a desired gap is formed on the liquid crystal display elements by an electric insulator, and the substrate and the glass electrode plate are set at a desired gap by the post.

(2) The liquid crystal display device of claim 1, characterized in that: the electric insulator performs a light shielding in the liquid crystal driving elements.

(3) The liquid crystal display device of claim 1, wherein the liquid crystal driving element is a thin film transistor comprising a gate electrode, source and drain electrodes, an insulating film formed in contact with the gate electrode and a semiconductor layer formed in contact with the insulating film, both ends being in contact with the source and drain electrodes.

(4) The liquid crystal display device of claim 1, wherein the electric insulator is a synthetic resin material formed at a predetermined position by a photolithography process.

3. Detailed Explanation of the Invention

Technical Field

The present invention relates to a image display device using liquid crystal and a thin film transistor (hereinafter, a TFT), and its objective is to control a gap between a glass plate having a transparent electrode stuck to one peripheral surface and a TFT substrate at a good accuracy and attempt to shield light to the TFT.

Background Art

In recent years, thin display devices as a display device substituting a conventional CRT have been actively developed. Among the thin display devices, a liquid crystal display device exceeds other types of devices in the aspect of power, driving voltage and lifespan, and is greatly expected as a future display device. Generally, liquid crystal display devices are classified into a dynamic drive type and a static drive type. The latter is excellent in the aspect of power and driving voltage. The static drive type liquid crystal display device generally comprises an upper glass substrate and a lower semiconductor integrated circuit substrate, and displays characters, graphs or images by selecting a liquid crystal driving element arranged in a matrix on the semiconductor integrated circuit as an external selection circuit, and applying a voltage to the liquid crystal. Recently, there have been made studies of a liquid crystal display device in which the semiconductor integrated circuit is formed as a TFT not on a semiconductor substrate but on an insulating substrate having a superiority in terms of large surface area and low cost. A general circuit diagram thereof will be shown in FIG.1.

FIG.1(a) is one portion of a matrix type arrangement view of liquid crystal driving elements (pixels) formed as TFTs on an insulating substrate used for a static drive type liquid crystal display panel. The region surrounded by 1 of the drawing is a

display region, wherein pixels 2aa, 2ab, 2ba, and 2bb are arranged in a matrix format. 3a and 3b represent a video signal line to the pixels, and 4a and 4b represent a timing signal line to the pixels. FIG.1(b) shows a circuit diagram of one pixel, especially, an equivalent circuit diagram for the pixel 2aa. A data signal is maintained in a condenser 6 by a switching transistor 5. The data signal is applied as an electric field to liquid crystal 7 by a common electrode 72 formed on a glass panel facing a liquid crystal driving electrode 71 corresponding to each of the pixels on the insulating substrate, and thereby generates a contrast. Generally, in case of utilizing this liquid crystal display panel for a image display purpose (for use in a television), timing is applied to each scan line by linear sequential scanning, and a signal voltage is maintained in the condenser corresponding to each of the pixels. In case of utilizing the liquid crystal display panel for a television, the response of liquid crystal is fine, and a relatively good image can be acquired.

FIG.2(a) shows a plane view of a unit pixel as shown in FIG.1(b) integrated in a circuit on the glass plate by a TFT. For example, a liquid crystal display device in which the dimension of the unit pixel is $220\mu\text{m} \times 165\mu\text{m}$. The TFT 5 is comprised of a source 202, a drain 203 and a gate 204. An ITO (Indium Tin Oxide) 208 forms a condenser 6 along with a common base ITO 206 through a thin silicon oxide film 207.

FIG.2(b) is a cross sectional view taken along line X-X' of FIG.2(a). FE-TN liquid crystal or G-H liquid crystal 7 or G-H liquid crystal 7 is charged between a glass substrate 21 with a TFT 1 and a glass substrate 22 with a transparent electrode 23 stuck to one peripheral surface, thereby forming a liquid crystal cell.

Light 10 incident from the top portion of the glass substrate 22 passes through the liquid crystal 7 only in one direction for vibrating light by a deflector plate 25, and

passes through the glass substrate 21 and a deflector plate 24. An electric field is applied to the liquid crystal and liquid crystal molecules are twisted by applying a desired potential between an ITO 23 and an ITO 208, and the transparency for the liquid crystal 7 of the light 10, thereby obtaining a transmission type liquid crystal display device.

FIG.3 shows the glass substrate 21 of FIG.2(b) where the above circuit with a TFT, condenser, etc. integrated thereto is cut, and a given gap 13 is disposed between the glass substrate 22 with a transparent electrode 23 stuck to one peripheral surface and the glass substrate 21 by using spacers 11. The gap 13 is sealed with liquid crystal 7. By a sealant 12 made of a suitable resin, the discharge of liquid crystal is prevented and the penetration of moisture is avoided.

In such a type of a display device, a cut glass substrate 21 has a large dimension of 44mm×56mm while it has a thickness no more than 1mm. Thus, a deviation generated in a thermosetting process of the sealant 12 causes bending of the glass substrate 21 after thermosetting even if assembling is started with the glass substrate 21 not bent, and causes the center of the glass substrate 21 approach to the glass substrate 22, as shown in FIG.3(a), or be spaced therefrom as shown in FIG.3(b).

The gap 13 is only 5~10 μ m in dimension, thus it is very hard to control deviation generated in a thermosetting process. Because the gap 13 is a gap of the liquid crystal 7, a change in the gap 13 causes a change in electric field strength applied to the liquid crystal 7, and this results in a change in the response speed or transparency of the liquid crystal. Thus, the uniformity of images is sharply reduced, and in extreme cases, liquid crystal may not be twisted at the center part of the screen. It is inevitable that the glass substrate where the integration circuit is formed by the TFT is bent more or less,

and in this case, a cross section, not of such a simple shape as shown in FIG.3 but of a more complicated shape, is created, thereby making the non-uniformity of both surfaces to have a moiré pattern.

Anyway, it is considerably hard to stick the large glass substrate 21 of no less than 44mm×56mm to the glass substrate 22 only with the spacers 11 arranged only in peripheral parts. Thus, glass fibers are finely cut to several tens of μm and dispersed on the surface of the glass substrate 21 at a proper density and used as a substitute for the spacers, and the technique of sealing the glass substrates 21 and 22 with a sealant while applying pressure thereto is attempted. The glass fibers have a small difference in their diameter, and even in the case that they are actually applied to assembling, the uniformity of images is sharply improved, and the operating state of the liquid crystal is extremely uniform too.

However, black and white are reversed by a potential given to the ITO 23 a great deal of point defects and line defects are created and picture quality is deteriorated in a difference sense from the conventional art to lower an assembly yield. This is because as shown in FIG.4, in the process of pressing and sealing the glass fibers 31 dispersed on the glass substrate as spacers, a thin oxide film 207 for a condenser is destroyed from the ITO 208 and is dispersed here and there on the lines of a source 202 and a gate 204, thereby cutting the lines. If the shape of the glass fibers 31 has a shorter or the same diameter, the pressure on applying pressure to the glass fibers and sealing them is made uniform and has a less probability of being disposed on the lines. But, in reality, it is assumed that the occurrence of the aforementioned defects is inevitable since there is a limitation on the cut length of the fibers and there is a difference in diameter. It can be easily presumed that although if the fibers themselves are soft, the

above destruction caused from the collapse of the fibers may be avoided, but this cannot guarantee a better accuracy of the gap 13.

[Object of the Invention]

For these reasons, the present inventors had to give up the idea of introducing the control of a gap 13 by glass fibers. The point of this invention is a result of devising a material and shape which do not disturb the arrangement of liquid crystal molecules and destroy an integrated circuit utilizing a TFT. Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.5.

[Construction of the Invention]

First, as for the shape of spacers, it is preferable to contact with an integrated circuit by a line or point like a cylinder or sphere since a pressure per unit area of contact points becomes larger, and more of a contact area is required. Next, as for the arrangement of spacers, in the technique of scattering spacers on an integrated circuit, they are disposed on an ITIO at a probability that however small the spacers are, they exist. Of course, since liquid cannot exist there, the transmittance of light using liquid crystal cannot be controlled. Further, the flow of liquid crystal is disturbed, smear is generated in the orientation state of liquid crystal, thereby leading to the deterioration of picture quality along with the aforementioned phenomenon. Therefore, the arrangement which avoids the ITO top is required. Such a selective arrangement cannot help but depends on a photography process utilizing photosensitive resin. Finally, as for the material of the spacers, even if the spacers are wrongly arranged on a TFT integrated circuit or there is a crack or pinhole in an oxide film on the integrated circuit, the spacers have to be electrically insulating so that a transparent electrode may not be shorted with a metal line or semiconductor layer.

As a result of considering the above, in the present invention, as shown in FIG.5, a columnar electric insulator 41 is stuck and formed selectively higher than the ITO 208 in an area except the ITO 208. A cross section contacting the glass substrate 22 of the electric insulator 41 is not necessarily limited to a rectangular shape as shown in FIG.5.

As electric insulating materials used for the TFT integrated circuit, a silicon oxide film, a silicon nitride film, etc. formed by CVD (chemical vapor deposition) can be used. Considering that the required thickness of the columnar spacers 41 is 5~10 μ m, it is expected there may be considerable technical difficulties in the uniformity of their thickness and their etching direction.

[Embodiment]

In order to avoid the above problems, an embodiment of this invention aims at and employs polyimide resin. Polyimide is an organic polymer and a liquid having a high viscosity, is cured by heat treatment of 200~800°C called curing, and has superior heat resistance, moisture resistance and electric insulation property after curing. Further, polyimide is capable of treatment of photosensitive resins because it is capable of rotational application by a spinner and is easily ashed by oxygen gas plasma, and polyimide is widely used as a passivation or multilayer wire in the integrated circuit. Besides, it also turns out that polyimide does not melt in liquid crystal after heat curing. Thus, after forming a source 202 and a drain 208, polyimide is applied thickly to several μ m on the whole surface, left selectively in a prescribed area on a TFT except the ITO208, heat-cured and the columnar insulator 41 is obtained. In order to selectively leave polyimide, a photography process utilizing photosensitive resin is carried out, or

photosensitive polyimide is used. Further, insulating resin having the same property as polyimide can be used for the present invention.

Meanwhile, it is often the case that if external light is incident directly on the TFT surface, a light conducting effect is generated in a semiconductor layer 205, and a change in waveform or a change in voltage is caused when transmitting various kinds of signals by the TFT, thereby failing to maintain normal device characteristics. However, by forming the columnar electric insulator 41 on the TFT, a light shielding effect to a channel area in a semiconductor layer 205 formed by the source 202 and the drain 208 is performed simultaneously, and an effect for reducing a leak current by a light by one digit or more is also generated.

[Effect of the Invention]

As apparently explained above, in the present invention, there is no orientation smear or the destruction of the integrated circuit at all as compared to a conventional spacer material, and an assembly yield of a process for sticking a glass substrate on which a TFT is formed and another glass substrate is almost 100%, by placing a lot of insulating columnar substances on the TFT, and constituting them as a spacer. Moreover, a light shielding effect of the TFT can be performed simultaneously, and a leak current by light can be reduced greatly.

4. Brief Explanation of the Drawings

FIG.1(a) is a matrix arrangement view of a liquid crystal display device.

FIG.1(b) is an equivalent circuit diagram for one liquid crystal display pixel.

FIG.2(a) is a plane view of a unit pixel in the device of FIG.1.

FIG.2(b) is a cross sectional view taken along line X-X' of FIG.2(a).

FIGs.3(a) and 3(b) are cross sectional views in which a glass substrate formed by a conventional method and a glass substrate with a TFT are sealed.

FIG.4 is a cross sectional view showing a state in which glass fibers destroyed the TFT.

FIG.5 is a cross sectional view of one embodiment of a liquid crystal display device based on the structure according to the present invention.

5 : TFT

6 : condenser for integration

7 : liquid crystal

21 : glass substrate

206 : ITO

207 : oxide film

208 : ITO

22: opposite glass substrate

23 : ITO

41 : columnar electric insulator

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報(A)

昭60-164723

⑫ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和60年(1985)8月27日

G 02 F 1/133

1 1 8

D-8205-2H

1 2 3

8205-2H

G 09 F 9/00

6731-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

⑭ 発明の名称 液晶表示装置

⑮ 特 願 昭59-20490

⑯ 出 願 昭59(1984)2月7日

⑰ 発 明 者 坂 井 徹 東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコー電子工業株式会社内

⑱ 出 願 人 セイコー電子工業株式会社 東京都江東区亀戸6丁目31番1号

⑲ 代 理 人 弁理士 最 上 務

明 細 書

発明の名称

液晶表示装置

特許請求の範囲

(1) 表示パネルを構成する一方の基板上に複数個の液晶駆動用素子をマトリックス状に配置した基板と、前記基板の対向面に透明電極を付けたガラス電極板の周辺を接着剤で接合することにより前記基板とガラス電極板とが所定の間隙を有する状態が形成され、この間隙に液晶材料を有する液晶表示装置において、前記液晶駆動用素子上に所望の間隙に対応した高さの支柱を電気絶縁体により形成し、該支柱により前記基板とガラス電極板を所望の間隙に設定することを特徴とする液晶表示装置。

(2) 前記電気絶縁体が、液晶駆動用素子における遮光を成すことを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の液晶表示装置。

(3) 前記液晶駆動用素子が、ゲート電極と、ソ

ースおよびドレイン電極と、前記ゲート電極に接して形成される絶縁膜と、該絶縁膜上に接して形成されかつその両端がそれぞれ前記ソースおよびドレイン電極と接する半導体層とを有する薄膜トランジスタであることを特徴とする特許請求の範囲第1項又は第2項に記載の液晶表示装置。

(4) 前記電気絶縁体が、所定の位置にフォトリソグラフィ工程により形成された合成樹脂材料であることを特徴とする特許請求の範囲第1項ないし第3項に記載の液晶表示装置。

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、液晶と薄膜トランジスタ(以下、TFTと略す)を用いた画像表示装置に関するものであって、一主面上に透明電極を被覆させたガラス板とTFT基板との間隙を精度よく制御し、かつTFTへの遮光を図ることを目的とする。

(従来技術)

近年、従来のCRTに代る表示装置として薄型

の表示装置の開発が盛んに進められている。薄型表示装置の中でも液晶表示装置は電力、駆動電圧寿命の点で他を凌駕しており今後の表示装置としての期待は大きい。一般に液晶表示装置はダイナミック駆動方式とスタティック駆動方式があり、後者の方が電力、駆動電圧の点ですぐれている。スタティック駆動方式の液晶表示装置は、一般に上側ガラス基板と、下側半導体集積回路基板より構成されており、前記半導体集積回路上にマトリックス状に配置された液晶駆動用素子を外部選択回路にて選択し、液晶に電圧を印加することにより、任意の文字、グラフあるいは画像の表示を行なうものである。最近では、前記半導体集積回路を、半導体基板上にではなく、大面積化、低コスト化における優位性により、絶縁基板上にTFTとして形成した液晶表示装置に関する研究が特に活発である。その一般的な回路図を第1図に示す。

第1図(a)はスタティック駆動方式の液晶表示パネルに用いる絶縁基板上のTFTより構成された液晶駆動素子(絵素)のマトリックス状配置図の

-8-

ラス基板上にTFTにより集積回路化した場合の平面図を示し、例えば単位画素の大きさを $220\mu\text{m} \times 165\mu\text{m}$ とした液晶表示装置が形成される。TFTは、ソース202、ドレイン208およびゲート204よりなり、ITO(インジウム錫酸化物)208は薄い酸化シリコン膜207を介してコモン電位のITO206とともにコンデンサ6を形成している。

第2図(b)は第2図(a)のX-X'線上の断面図である。TFT1を形成したガラス基板21と一主面上に透明電極28を被着形成したガラス基板22との間に、FET液晶またはO-E液晶7を充填することにより液晶セルが構成されることになる。

ガラス基板22上方より入射した光10は、偏光板25により光の振動方向を一方向のみとされて液晶7を通り、ガラス基板21、偏光板24を経て通過する。ITO28およびITO208の間に所望の電位を印加することにより、液晶7に電界を加え液晶分子をツイストさせ、光10の液

-5-

1部分である。図中の1で囲まれた領域が表示領域であり、その中に絵素2aa, 2ab, 2ba, 2bbがマトリックス状に配置されている。8a, 8bは絵素へのビデオ信号ライン、また4a, 4bは絵素へのタイミング信号ラインである。1つの絵素の回路図として特に絵素2aaについての等価回路図を第1図(b)に示す。スイッチングトランジスタ5によりコンデンサ6にデータ信号を保持させる。データ信号は、絶縁性基板上の各絵素に対応して形成された液晶駆動用電極71と対向したガラスパネル上に形成された共通電極72により液晶7に電界として印加され、それによりコントラストを生じる。一般に画像表示用(テレビ用)として本液晶表示パネルを用いる場合は、線順次走査により、各走査線毎にタイミングをかけ、各絵素に対応したコンデンサに信号電圧を保持させる訳である。このように液晶表示パネルをテレビとして用いた場合には、液晶の応答も良く比較的良好な画像が得られる。

第2図(a)は、第1図(b)に示される単位画素をガ

-4-

晶7に対する透明率を制御することにより、透過型の液晶表示装置が得られることになる。

第8図は前述のTFT、コンデンサ等が一体化された集積回路の製作が終了した第2図(b)の状態のガラス基板21を切り出し、スペーサ11を用いて一主面上に透明電極28を被着したガラス基板22とガラス基板21との間に所定の間隙18を設けた状態を示す。この間隙19には液晶7が封入される。適当な樹脂より成るシール材12により、液晶のしみ出しを防止するとともに湿気の浸入を阻止する。

この種の表示装置において、切り出されたガラス基板21は $44\text{mm} \times 56\text{mm}$ と非常に大きい一方、厚みはわずか 1mm しかない。従って、シール材12の熱硬化工程で発生した歪は、例えばガラス基板21がそっていない状態で組み立てを始めても熱硬化後はガラス基板21に歪を生ぜしめ、第8図(a)に示すようにガラス基板21の中央がガラス基板22に接近するか、あるいは第8図(b)に示すように遠ざかってしまう。

-6-

前記間隙18は規格上はわずから5~10 μ mであるので熱硬化工程で発生する歪を制御するのは極めて困難である。間隙18は液晶7の間隙であるので、間隙18の変化は液晶7にかかる電界強度の変化をもたらす、このことは液晶の応答速度や透過率の変化となって現われる。従って、画像の均一性は著しく失われ、極端な場合には画面の中央部では液晶がツイストしないことも起りうる。TFTによる集積回路の形成が終了したガラス基板にはなにかしかなのそりが必ず発生しておりこの場合には第8図に示したような単純な形でなくもっと複雑な断面を生じ、従って画面の不均一性もモアレ模様風のものととなる。

いずれにしても44 μ m \times 56 μ mもあるような大きなガラス基板21を周辺部のみに配列したスペーサ11だけでそれなりのガラス基板22と接合させることにはかなりの無理がある。そこでガラスファイバーを数十 μ m程度に細かく切ったものをガラス基板21の表面に適当な密度で分散させてスペーサの代りとし、ガラス基板21および

-7-

があるために上記のような欠陥の発生は避け得ないものであると考えられる。ファイバー自身が軟かければファイバーがつぶれることにより上記のような破壊は免れるであろうが、それでは間隙13の精度をより良く保つことはできないと容易に推測できる。

(発明の目的)

以上のような理由により本発明者らはガラスファイバーによる間隙18の制御については導入を断念せざるを得なかった。スペーサとして液晶分子の配列を乱すことなく、かつTFTによる集積回路を破壊しないような材質および形状を考案した結果が本発明の要点であって、以下に本発明の実施例にもとづいて、第5図とともに説明する。

(発明の構成)

まずスペーサの形状であるが円柱または球のように線または点で集積回路と接触するものは接触点において単位面積あたりの圧力が大きくなるので好ましく、なにかしかなの接触面積が必要である。つぎにスペーサの配置であるが、第4図のごと

-8-

び22とを加圧しながらシール材で封入するという手法が試みられた。ガラスファイバーはその径のバラッキも少なく、実際に組み立てに導入した結果においても、画像の均一性は著しく向上し、液晶の動作状態も極めて一様となった。

しかしながら、ITO28に与える電位により白黒は反転するが非常に多くの点状欠陥、線欠陥が発生し、従来とは異なった意味で画質が劣化し組立て歩留が下ってしまった。その原因は第4図に示すようにスペーサとしてガラス基板21上に分散されたガラスファイバー81が加圧、封入する工程において、薄いコンデンサ用の酸化膜207をITO208上から破壊すること、およびソース202、ゲート204のライン上にたまたま分散されることによりラインを分断してしまうことによるものと判明した。ガラスファイバー81の形状をより短くかつ同一の径であれば加圧封入時の圧力もより均等に加わりライン上に位置する確率も小さくなるはずであるが、実際にはファイバーの切断長さには限界があり、径にもバラッキ

-8-

く集積回路上にばらまきという手法ではスペーサがどんなに小さくてもある確率でITO上に位置し、そこではもちろん液晶は存在できないのであるから液晶による光の透過率の制御はありえないし、また液晶の流れが乱れるため液晶の配向状態にむらを生じて上述の現象ともあいまって画質の劣化をもたらす。従って、少なくともITO上を避けるような配置が必要である。このような選択性配置はもちろん感光性樹脂を用いたフォトリソに頼らざるを得ない。最後にスペーサの材質であるがもし万一TFT集積回路上で誤って配置されたり集積回路上の酸化膜にクラックやピンホールがあっても透明電極がスペーサ材を通して金属配線や半導体層とショートしないように電氣的に絶縁性でなければならぬ。

以上述べたことを配慮した結果、本発明においては第5図に示すようにITO208以外の領域に柱状の電気絶縁体41をITO208よりも高く選択的に被層形成した。電気絶縁体41のガラス基板22との接触断面は第5図に示したような

-10-

必ずしも方形に限られるものではない。

TFTの集積回路で用いられる電気絶縁性物質としてはCVD(化学気相成長法)による酸化シリコン膜、窒化シリコン膜などがあるが、前記柱状スペーサ41の厚みが5~10 μ mも必要であることを考えると、それらの厚みの均一性やエッチング方法に関してかなり技術的困難が伴うと予想される。

(実施例)

本発明の実施例においては上記した問題为了避免ため電気絶縁体としてポリイミド樹脂に注目しこれを採用した。ポリイミドは有機高分子で粘性の高い液体であり、キュアと称する200~800℃の熱処理によって硬化し、硬化後は優れた耐熱性、耐湿性、絶縁性を有する。更にポリイミドはスピナによる回転塗布が可能であることと、微細ガスプラズマによる灰化が容易であることから感光性樹脂なみの取り扱いができ集積回路においてパシベーションあるいは多層配線時の層間絶縁膜として広く用いられるようになっている。更に

-11-

となった。

(発明の効果)

以上の説明からも明らかなように本発明においては絶縁性の柱状物質をTFT上に多数配置してスペーサとして構成することにより、従来のスペーサ材に比べ配向むらや集積回路の破綻等については皆無となり、TFTを形成したガラス基板ともう一方のガラス基板とを接合する工程の組立て歩留りはほぼ100%となった。また同時にTFTに関しての遮光効果をも果たし光リーク電流も大幅に低減することができた。

以上のごとく本発明は高性能で耐光性の大きい液晶表示装置を高歩留りで実現する上で利用価値の極めて大きいものである。

図面の簡単な説明

第1図(a)は液晶表示装置のマトリックス配置図、第1図(b)は液晶表示画面の1つについての等価回路、第2図(a)は第1図の装置における単位画面の平面図、第2図(b)は第2図(a)のX-X'線断面図、

-13-

熱硬化後は液晶に溶解しないことも判っている。そこで、ソース202、ドレイン208の形成後全面にポリイミドを数 μ mと厚く塗布し、ITO208以外のTFT上の所定の領域に選択的に残し、熱硬化させ柱状絶縁体41としたものである。ポリイミドを選択的に残すためには感光性樹脂を用いたフォトリソ工程を実施するか、あるいは感光性ポリイミドを使用すれば良い。なお、ポリイミドと同等の性質を有する絶縁性樹脂も本発明に使用することができる。

一方、外部光が直接TFT表面に入射すると半導体層205において光伝導効果が生じ、TFTによる各種信号伝達の際に波形の変化や電圧の変化を招き、正常な素子特性を維持できなくなることがしばしば生じていた。ところが、前記柱状電気絶縁体41をTFT上に形成したところ、ソース202、ドレイン208とによって形成される半導体層205におけるチャネル領域への遮光効果も同時に果たすこととなり、光によるリーク電流を1桁以上低減させるという効果も生じること

-12-

第8図(a)、(b)は従来工法によるガラス基板とTFTを形成したガラス基板との封止断面図、第4図はガラスファイバーがTFTを破壊している状態を示す断面図、第5図は本発明による構造に基づいた液晶表示装置の一実施例についての断面図である。

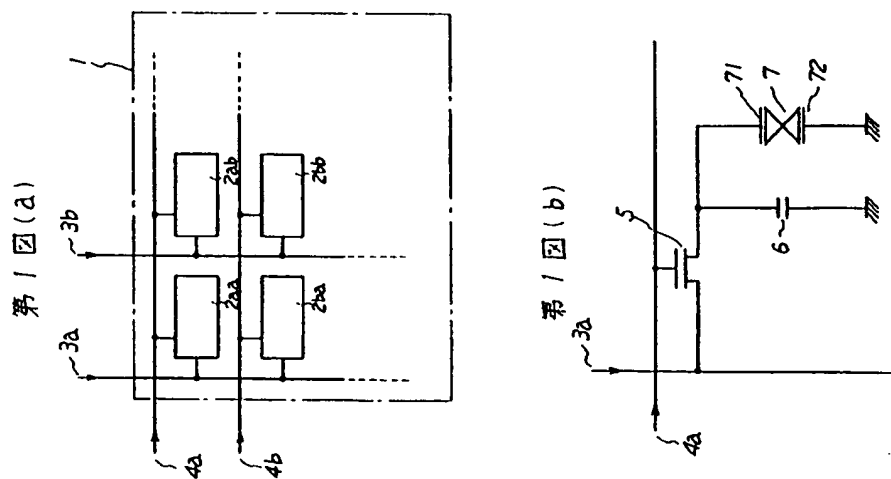
5・・・TFT 6・・・蓄積用コンデンサ 7・・・液晶 21・・・ガラス基板 206・・・ITO 207・・・酸化膜 208・・・ITO 22・・・対向ガラス基板 23・・・ITO 41・・・柱状電気絶縁体。

以 上

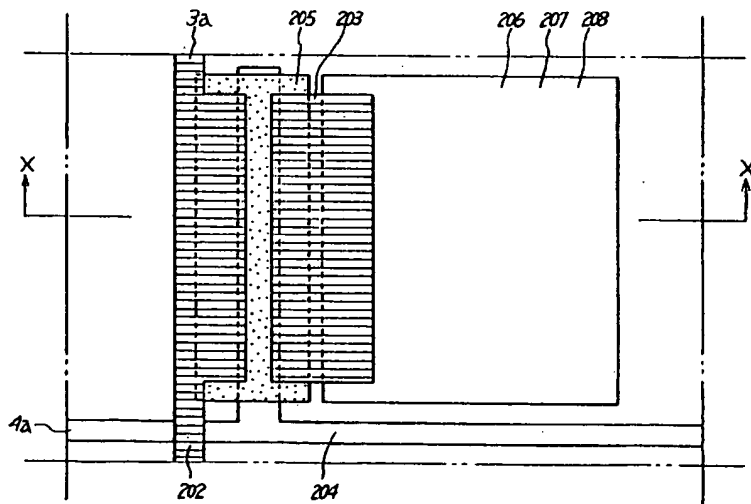
出 願 人 セイコー電子工業株式会社

代 理 人 弁 理 士 最 上 務

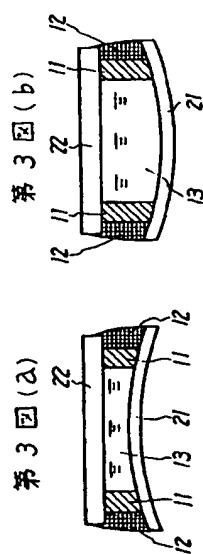
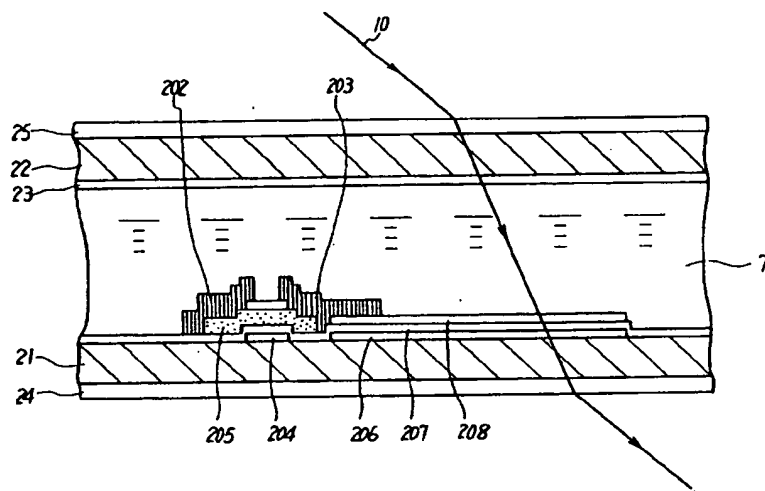
-14-



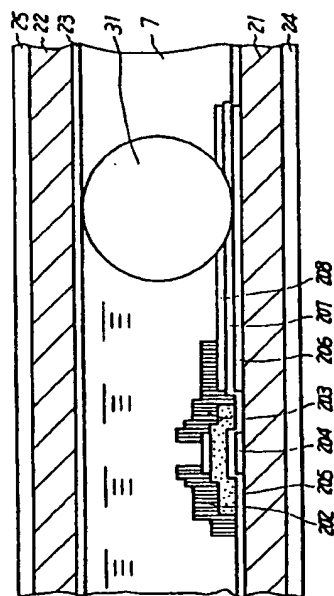
第2図(a)



第2図(b)



第4図



第5図

